

553, 654

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
4 novembre 2004 (04.11.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/094339 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :

C04B 35/573

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/000929

(22) Date de dépôt international : 15 avril 2004 (15.04.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

03/04749

16 avril 2003 (16.04.2003)

FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :
SICAT [FR/FR]; 14, avenue Hoche, F-75008 Paris (FR).
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75794
Paris Cedex 16 (FR). UNIVERSITE LOUIS PASTEUR
STRASBOURG [FR/FR]; 4, rue Blaise Pascal, F-67000
Strasbourg (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
PHAM-HUU, Cuong [FR/FR]; 3, rue des Eglises,
F-67700 Saverne (FR). NGUYEN, Patrick [FR/FR];
17, rue Molsheim, F-67000 Strasbourg (FR). PHAM,
Charlotte [FR/FR]; 3, rue des Eglises, F-67700 Saverne
(FR). LEDOUX, Marc, Jacques [FR/FR]; 11, rue d'Ussé,
F-67000 Strasbourg (FR).

(74) Mandataire : SCHMIDT, Martin, Peter; Pechiney, 217,
cours Lafayette, F-69451 Lyon Cedex 06 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de
la demande antérieure (règle 4.17.iii) pour la désignation
suivante US

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale
— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications, sera republiée si des modifications sont re-
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: USE OF A SILICON CARBIDE-BASED CERAMIC MATERIAL IN AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

(54) Titre : L'UTILISATION D'UN MATERIAU CERAMIQUE A BASE DE CARBURE DE SILICIUM DANS LES MILIEUX
AGRESSIFS

(57) Abstract: The invention relates to the use of an SiC-based composite refractory material as an inner coating for an aluminium
smelting furnace or as a coating for a fused salt electrolytic cell. Said material contains inclusions, comprising at least one α -SiC
part, in a β -SiC matrix.

(57) Abrégé : L'invention concerne l'utilisation d'un matériau réfractaire composite base de SiC comme revêtement intérieur de four
de fusion d'aluminium ou comme revêtement de cuve d'électrolyse en sel fondu. Ce matériau contient des inclusions, dont au moins
une partie en α -SiC, dans une matrice de β -SiC.

WO 2004/094339 A1